J. Humlíček FKL II, jaro 2022/23

2. Translační symetrie, reciproká mříž, Brillouinovy zóny, hustota stavů

Invariance nekonečného krystalu vůči translacím

$$\vec{T}_{\vec{n}} = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3$$
, n_1, n_2, n_3 celé. (1.1)

14 možných mříží (Bravaisovy mříže). Podle bodové symetrie - syngonie s jedním nebo více možnými typy:

(prostá),
(prostá, bazálně centrovaná),
(prostá; bazálně, plošně, prostorově centrovaná),
(prostá, bazálně centrovaná),
(prostá),
(prostá),
(prostá; plošně, prostorově centrovaná, SC, FCC,

Jednoelektronové stacionární stavy

$$H\psi(\vec{r}) = \left[\frac{p^2}{2m} + V(\vec{r})\right]\psi(\vec{r}) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r})\right]\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r}) \quad (1.2)$$

s periodickým potenciálem V:

$$V(\vec{r} + \vec{T}_{\vec{n}}) = V(\vec{r}) .$$
(1.3)

Translace nemění Hamiltonián, hustota pravděpodobnosti výskytu elektronu v místech \vec{r} a $\vec{r} + \vec{T}_{\vec{n}}$ je stejná,

$$\left|\psi(\vec{r}+\vec{T}_{\vec{n}})\right|^2 = \left|\psi(\vec{r}_{\vec{n}})\right|^2$$
 (1.4)

Vlnová funkce se tedy může lišit násobením komplexní jedničkou

$$C_{\vec{n}} = e^{i\varphi(T_{\vec{n}})},\tag{1.5}$$

kde φ je skalární reálná funkce vektorového argumentu. Provedení dvou translací \vec{T}_n a \vec{T}_m vede k násobení původní vlnové funkce faktorem $C_m C_n$, funkce φ v předchozí rovnici (1.5) tedy musí být lineární kombinací složek vektoru translace, neboli skalárním součinem:

$$\varphi(\vec{T}_{\vec{n}}) = \vec{k} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}.$$
(1.6)

Vlastní funkce Hamiltoniánu je tedy indexována vektorem k, který zaručuje požadované vlastnosti při translacích o mřížové vektory:

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\vec{r}}u_{\vec{k}}(\vec{r})$$
, kde $u_{\vec{k}}(\vec{r}+\vec{T}_{\vec{n}}) = u_{\vec{k}}(\vec{r})$. (1.7)

To je Blochova funkce, s rovinnou vlnou $e^{i\vec{k}\vec{r}}$ a translačně invariantní částí *u*. Vektor *k*, indexující Blochovu funkci, není určen jednoznačně. Přičteme-li k němu takový vektor *K*, který ve skalárním součinu s translačními vektory mříže dá celočíselný násobek 2π , hodnota fázového faktoru $C_{\vec{n}}$ se nezmění. Hledejme takové vektory ve tvaru lineární kombinace trojice vektorů

$$\vec{K}_{\vec{q}} = q_1 \vec{b}_1 + q_2 \vec{b}_2 + q_3 \vec{b}_3$$
, q_1, q_2, q_3 celé. (1.8)

Splnění podmínky

$$\vec{K}_{\vec{q}} \cdot \vec{T}_{\vec{n}} = 2\pi m , m \text{ celé}, \tag{1.9}$$

zajišť ují vektory

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega_0} \vec{a}_2 \times \vec{a}_3 , \ \vec{b}_2 = \frac{2\pi}{\Omega_0} \vec{a}_3 \times \vec{a}_1 , \ \vec{b}_3 = \frac{2\pi}{\Omega_0} \vec{a}_1 \times \vec{a}_2.$$
(1.10)

 $\Omega_0 = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$ je objem primitivní buňky mříže vytvořené vektory *a*. Průměty jednotlivých vektorů *b* do vektorů *a* se stejným indexem mají velikost 2π , s různými indexy jsou nulové:

$$\vec{b}_q \cdot \vec{a}_n = 2\pi \delta_{qn}$$
, $q, n = 1, 2, 3.$ (1.11)

Vektory $\vec{K}_{\vec{q}}$ tvoří reciprokou mřížku (vzdálenosti v ní mají rozměr převrácené délky). Konstrukce reciproké mříže zajišťuje, že patří do téže syngonie jako výchozí ("přímá") mříž. Prostý a bazálně centrovaný typ se také zachovává, plošně a prostorově centrované typy pro ortorombickou a kubickou syngonii se navzájem vymění.

Vektory indexující Blochovu funkci jsou ekvivalentní, pokud se liší o vektor reciproké mříže – vybíráme je z první Brillouinovy zóny (Wignerova-Seitzova buňka reciproké mříže): zvolíme některý mřížový bod reciproké mříže za počátek a body v poloviční vzdálenosti k dalším mřížovým bodům vedeme roviny kolmé na příslušné spojnice. K nejbližším rovinám zvoleného počátku je první Brillouinovou zónou (1. BZ). Skalární součiny s primitivními vektory jsou omezeny na oblast velikosti 2π ,

$$-\pi \le \vec{k} \cdot \vec{a}_j \le \pi$$
, $j = 1, 2, 3$. (1.12)

Konečné rozměry - (cyklické) Bornovy-Kármánovy podmínky, s opakováním hodnot vlnových funkcí v dostatečně velkých vzdálenostech krystalu:

$$\psi(\vec{r} + N_j \vec{a}_j) = \psi(\vec{r}) , \ j = 1, 2, 3 ,$$
 (1.13)

 N_j jsou velká kladná. Očekáváme, že při dostatečně velkých N_j budou vlastnosti takového krystalu prakticky stejné jako vlastnosti

nekonečného nebo "dostatečně velkého" (vzhledem k meziatomovým vzdálenostem) krystalu. Mluvíme o "objemových" (nebo "bulkových") vlastnostech. Zřejmě zde zanedbáváme vliv povrchu nebo rozhraní k jiným materiálům. Takové přiblížení nebývá použitelné pro malé rozměry krystalů (v "nanostrukturách").

Periodické okrajové podmínky (1.13) vedou ke "kvazikontinuu" možných hodnot vektoru k v první Brillouinově zóně. Jsou to lineární kombinace primitivních vektorů reciproké mříže,

$$\vec{k} = k_1 \vec{b}_1 + k_2 \vec{b}_2 + k_3 \vec{b}_3 , \qquad (1.14)$$

s koeficienty k_i v rozsahu od $-\frac{1}{2}$ do $\frac{1}{2}$ s malým krokem $1/N_i$.

Klasifikace stacionárních stavů jednoelektronového Hamiltoniánu vektorem k (obvykle nahrazujeme kvazikontinuum možných hodnot kontinuem a používáme derivování podle jeho komponent a integrování přes ně) a dalším diskrétním indexem (kvantovým číslem) s označením n. Schroedingerova rovnice (1.2) s Blochovým tvarem vlnové funkce vyjde ve tvaru

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + \frac{\hbar^2}{2m}\left|\vec{k}\right|^2 - i\frac{\hbar^2}{m}\vec{k}\cdot\nabla + V(\vec{r})\right]e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}u_{\vec{k},n}(\vec{r}) = E_n e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}u_{\vec{k},n}(\vec{r}) ,$$
(1.15)

kde můžeme rovinnou vlnou $e^{i\vec{k}\vec{r}}$ dělit a máme rovnici pro periodickou část *u*. Tu stačí řešit v primitivní buňce a okrajové podmínky jsou dány periodicitou *u*. (Kvazi)spojitá změna energie *E* při změně vektoru *k* uvnitř 1. BZ při pevném *n* vede k rozsahu, označovaném jako *n*-tý pás; závislost na velikosti *k* v určitém směru v 1. BZ se označuje jako <u>disperze energie</u> v tomto směru. Soustava pásů pro daný krystal se označuje jako pásová struktura. Může v ní být interval bez povolených hodnot energie, ten pak tvoří pás zakázaných energií (gap). V nejhrubším pohledu můžeme tedy vyznačit rozsahy možných energií elektronů způsobem znázorněným v obrázku:



Přítomnost pásu zakázaných energií je pro polovodiče a izolátory podstatná, proto má i tento způsob svoje opodstatnění. Pro bulkový materiál je označení "polohy" v krystalu nepodstatné. Situace se ale změní, sledujeme-li heterostrukturu, t.j. dva odlišné materiály napojené na sebe "s atomární přesností". V našich idealizacích pak zacházíme s ostrým rozhraním mezi dvěma poloprostory, které jsou vyplněny materiály s různými pásovými strukturami jednoelektronových stavů. Chování elektronového systému je pak výrazně ovlivněno uspořádáním pásů na rozhraní; není jedno, je-li energie nejvyššího obsazeného stavu větší, rovná, nebo menší než tato energie v sousedním materiálu s jinou hodnotou gapu. V hořejším obrázku dostaneme jedno z možných uspořádání vodorovným posuvem pásů takovým, aby se nakreslené dva bloky energiových pásů dotkly.

Hustota stavů

Podrobnější informace o pásové struktuře jsou v hustotě stavů D(E). Rozumíme zde hustotu vůči hodnotám energie, neboli počet stavů P(E, E+dE) v intervalu mezi E a E+dE, vydělený šířkou tohoto intervalu dE:

$$D(E) = \frac{P(E, E + dE)}{dE} . \qquad (1.16)$$

Označíme-li jako $N_n(E)$ počet stavů od nejmenší možné hodnoty energie *n*-tého pásu (bezpečná volba je -∞) po argument *E*, můžeme s použitím předchozích úvah o kvazispojitých intervalech vektorů *k* a energií *E* použít derivaci této funkce, a hustotu stavů dostaneme jako součet přes všechna *n*:

$$D(E) = \sum_{n} D_{n}(E) = \sum_{n} \frac{dN_{n}(E)}{dE} \quad .$$
(1.17)

Ukázka hustoty stavů pro Si, Ge a α -Sn je v následujícím obrázku. Do předchozího nejjednoduššího schématu ji zredukujeme tak, že vyznačíme pás energií od zhruba -13 eV do nuly pro všechny tři materiály (to jsou energie obsazených stavů), pak je pás zakázaných energií šířky zhruba 1.2 eV (Si), 0.7 eV (Ge) a nulové šířky pro α -Sn. Navazující vyšší energie mají v naší idealizaci neobsazené jednoelektronové stavy.



Pro praktický výpočet hustoty stavů je velmi vhodná formule (1.16). Vzhledem ke kvazikontinuu možných hodnot vektoru k s ekvidistantními odstupy můžeme spočíst $N_n(E)$ jako objem reciprokého prostoru, který je ohraničený plochou $E_n(k) = E$, vydělený objemem připadajícím v reciprokém prostoru na jeden stav. Příspěvek n-tého pásu do hustoty stavů pak dostaneme zderivováním tohoto podílu podle energie E:

$$D_{n}(E) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}E} \frac{\iiint_{E_{n}(\vec{k}) < E}}{\frac{(2\pi)^{3}}{N_{1}N_{2}N_{3}\Omega_{0}}} = \frac{N_{1}N_{2}N_{3}\Omega_{0}}{(2\pi)^{3}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}E} \iiint_{E_{n}(\vec{k}) < E} \mathrm{d}^{3}\vec{k} .$$
(1.18)

Objem ohraničený ekvienergiovou plochou v hořejším vztahu můžeme snadno pro některé disperzní závislosti snadno spočíst. Provedeme tento výpočet pro kvadratickou disperzi energie kolem minima pásu,

$$E_n(k_x, k_y, k_z) = E_0 + \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{k_x^2}{m_x^*} + \frac{k_y^2}{m_y^*} + \frac{k_z^2}{m_z^*} \right), \ m_x^*, m_y^*, m_z^* > 0 .$$
(1.19)

Toto by byla disperze volného elektronu, kdyby tzv. efektivní hmotnosti m_x^*, m_y^*, m_z^* byly stejné a rovné hmotnosti elektronu ve vakuu. Krystalový potenciál ale situaci mění, setrvačnost elektronů může být různá v různých směrech a typicky se liší od setrvačnosti volného elektronu. Ekvienergiové plochy s disperzí (1.19) jsou elipsoidy, jejichž objem snadno najdeme. S použitím transformace

$$k_{j}^{'} = \frac{k_{j}}{\sqrt{m_{j}^{*}}}, j = x, y, z, d^{3}\vec{k} = \sqrt{m_{x}^{*}m_{y}^{*}m_{z}^{*}}d^{3}\vec{k}^{'}$$
 (1.20)

je objemový integrál ve vztahu (1.18) objemem třírozměrné v koule s kvadrátem poloměru $2(E-E_0)/\hbar^2$, tedy $(4/3)\pi[2(E-E_0)/\hbar^2]^{3/2}$. Derivováním podle *E* tedy dostaneme příspěvek pásu (1.19) do hustoty stavů ve tvaru

$$D_n(E) = \frac{4\pi\sqrt{2N_1N_2N_3\Omega_0}}{(2\pi\hbar)^3} \sqrt{m_x^* m_y^* m_z^*} \sqrt{E - E_0} \text{ pro } E > E_0. \quad (1.18)$$

Pro energie menší než E_0 je hustota stavů nulová (žádné takové stavy v tomto pásu nejsou).

Parabolickou disperzní relaci mají volné elektrony, pro které jsou navíc všechny tři efektivní hmotnosti stejné a rovné klidové hmotnosti elektronu ve vakuu, m_0 . Systém volných (neinteragujících) elektronů můžeme vložit no nekonečně slabého periodického potenciálu, ve kterém se disperzní relace nezmění, ale symetrie potenciálu se uplatní; to je koncept "prázdné mřížky" ("empty lattice").

Prázdná mřížka FCC, se zachovanou symetrií potenciálu, má pásovou strukturu z následujícího obrázku:



Jsou zde použity standardní symboly pro označení bodů a směrů vysoké symetrie, přiřazené kartézským souřadnicím v reciprokém prostoru podle následujícího obrázku:

Jaká je energiová závislost hustoty stavů?